

# 産業応用フォーラム

## 「次世代家電・民生用パワーデバイスの主役は何か

### —家電・民生PEとパワー半導体 次世代の針路を探る—

**概要：** 家電・民生分野のパワーエレクトロニクス応用はここ 50 年のパワー半導体の進化を原動力として、1980 年代の豊かな社会を背景とした本物・本格志向、1990 年代の地球環境問題に対応する省エネルギーなど、時代の要請に応えた新たな利便性を社会生活に提供し発展してきた。目下 2010 年代は、脱原発や再生可能エネルギー大量導入などのエネルギー供給の歴史的構造変化と、新素材や新構造などによるパワー半導体の革新的高性能化、ふたつの変革が注目される。本フォーラムでは、セット側から変革期を迎えた家電・民生パワーエレクトロニクスが求めるパワーデバイスの仕様や期待する効果を、デバイス側から IGBT, MOSFET, SiC, GaN など最新パワーデバイスの動向や今後の展望について、関心のある技術者、研究者の皆様を広く対象として解説し、次世代の針路を探ります。セット/デバイスの事業と研究のロードマップ構築に、また最新技術情報の獲得に、貴重な機会になると確信いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

**日時：** 2013 年 11 月 29 日（金） 13:00～16:45

**会場：** 電気学会 会議室 東京都千代田区五番町 6-2 HOMAT HORIZON ビル 8 階  
JR 総武線（中央線各駅停車）市ヶ谷駅下車、徒歩 2 分 TEL: 03-3221-7313

#### プログラム：

1. 13:00～13:05 開会、主催者挨拶
2. 13:05～13:15 総論 大森 英樹（大阪工業大学）
3. 13:15～13:45 家電・民生機器における次世代パワーデバイスへの期待と課題 叶田 玲彦（日立製作所）
4. 13:45～14:15 次世代パワーデバイス(SiC)のエアコン適用における期待と課題 齋藤 勝彦（三菱電機）
5. 14:15～14:45 MOSFET(Si)の最新動向と展望 入山 鋭士（インフィニオン）
6. 14:45～15:15 IGBT(Si)の最新動向と展望 小倉 常雄（東芝）  
休憩
7. 15:30～16:00 SiC デバイスの最新動向と展望 渡部毅代登（三菱電機）
8. 16:00～16:30 GaN デバイスの最新動向と展望 上田 哲三（パナソニック）
9. 16:30～16:40 総合討論
10. 16:40～16:45 主催者挨拶、閉会

**参加費（テキスト代含む）：** 会員（正員） ¥8,000-（不課税）、非会員（一般） ¥12,000-（税込）  
会員（准・学生員） ¥3,000-（不課税）、非会員（学生） ¥5,000-（税込）

**申込方法：** ○ホームページからのお申込み：<http://www.iee.or.jp/forum.html>

※お申込み後一週間程度経過しても『申込完了のお知らせ』の電子メールが届かない場合には下記（鷹箸）まで電子メールまたはファクシミリにてご連絡ください。

○電子メール、または FAX でのお申込み：「産業応用フォーラム「次世代家電・民生用パワーデバイスの主役は何か」参加申し込み」と題記し、会員/非会員の別、氏名、所属、連絡先（住所、電話、ファックス、電子メール）を添えて、11 月 19 日（火）までに以下へお申し込みください（定員 50 名に達し次第、締め切らせていただきます）。

（株）東芝 鷹箸 幸夫（タカノハシ ユキオ）

Fax 042-340-8127, e-mail: [yukio.takanohashi\(at\)toshiba.co.jp](mailto:yukio.takanohashi(at)toshiba.co.jp)

**参加費支払い方法：** 参加費は、当日に現金でお支払い願います。領収書は、原則としてフォーラム当日の日付で会場渡しとなりますが、その他のご指示がある場合は申込時にご連絡ください。

**主催：** 電気学会産業応用部門 家電・民生技術委員会（委員長 大森英樹）

**協賛：** IEEE. IES. Japan Chapter